



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



تحلیل و مقایسه خواص الکترواپتیکی دو ترکیب دی الکتریک $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ و $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{ZrO}_3$

سمانه غلام پور، جواد باعدی و فرشید قلعه‌نوی

سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

چکیده - خواص الکترواپتیکی ترکیب‌های BNZ و BNT در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی (DFT) با استفاده از روش پتانسیل کامل و امواج تخت افزوده خطی شده (FP-LAPW) و با بکارگیری تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. گاف‌های الکترونیکی و اپتیکی برای BNT به ترتیب مقادیر 1.9 eV و 2.2 eV بدست آمد؛ در حالی که برای ترکیب BNZ گاف الکترونیکی 1.45 eV و گاف اپتیکی 1.8 eV حاصل شد. در هر دو ترکیب از لحاظ اپتیکی یک ناهمسانگردی دیده شد که منجر به خاصیت دوشکستی برای این ترکیبات می‌شود.

کلید واژه - انرژی گاف، خواص الکترواپتیکی، BNZ ، BNT

Analysis and comparison of the electro-optical properties in two dielectric compounds $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ and $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{ZrO}_3$

Samane Gholampour, Javad Baedi, and Farshid Ghalenovi

Physics department, school of sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar

Abstract- The electro-optical properties of BNT and BNZ compounds were studied in density functional theory (DFT) frame using full potential and linearized augmented plane wave (FP-LAPW) and generalized gradient approximation (GGA). The electronic and optical gaps of BNT were obtained 1.9 eV and 2.2 eV respectively; but in BNZ compound, the values 1.45 eV for electronic gap and 1.8 eV for optical gap were achieved. Anisotropy for optical properties was seen in both compounds which results in birefringence characteristic for these compounds.

Keywords: BNT , BNZ , electro-optical properties, gap energy

۱- مقدمه

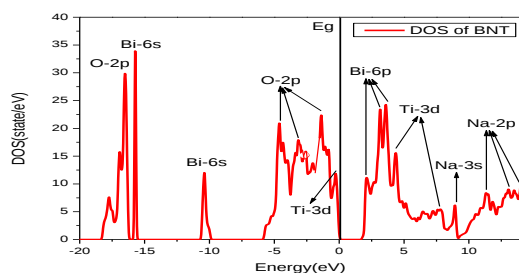
امروزه سرامیک‌های بدون سرب به طور گسترده در دستگاه‌های الکترونیکی مانند فعال کننده‌ها، حسگرها، مبدل‌ها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند [۱] چرا که هیچ سرب برای آلودگی محیط نداشته و همچنین بعضی از آنها ویژگی‌های پیزوالکتریکی، دی‌الکتریکی و فروالکتریکی خوبی از خود نشان می‌دهند. بنابراین مطالعه و بهبود این خواص یک زمینه‌ی کاری بسیار مورد توجه برای محققان محسوب می‌شود. از جمله‌ی این مواد ترکیب $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ (BNT) است که اولین بار توسط اسمولنسکی و همکارانش کشف شد [۲]. این ترکیب در سه فاز رومبوهدرال، تتراگونال و مکعبی دیده شده است که در فاز فروالکتریک دارای قطبش پسماند زیاد $P_r = 38 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ و نیز دمای کوری بالاست [۳ تا ۵]. در مقایسه با سرامیک BNT تک بلور آن دارای خواص پیزوالکتریکی خوب و خواص اپتیکی عالی می‌باشد [۵ تا ۹]. بنابراین در این پژوهش خواص الکترواپتیکی بلور BNT در فاز تتراگونال مورد بررسی قرار می‌گیرد. ترکیب دیگری که نیز در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است بلور $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{ZrO}_3$ (BNZ) می‌باشد که فاقد سرب بوده و اولین بار در سال ۲۰۰۷ توسط ک. لیلی و همکارانش معرفی شد [۱۰ و ۱۱]. همچنین در ادامه ویژگی‌های این دو ترکیب با یکدیگر مقایسه شده است.

۲- روش محاسبات

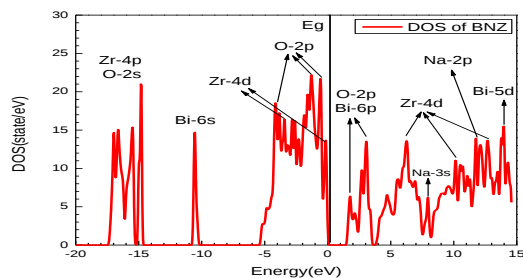
به منظور محاسبه‌ی خواص الکترونیکی و اپتیکی بلور مورد نظر، ابتدا می‌بایست معادله‌ی شرودینگر برای سیستم بس الکترونی در پتانسیل آن شبکه حل شود. برای این منظور از تقریب‌های مختلف و کدهایی محاسباتی در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) استفاده می‌شود. از جمله آنها، روش پتانسیل کامل با امواج تخت افزوده خطی (FP-LAPW) و تقریب شیب تعمیم یافته (Perdew-Burke-Ernzerhof) GGA است که در اینجا به کار گرفته شده‌اند. برای ثابت‌های شبکه‌ی بلوری a, b و c یک بار از مقادیر تجربی [۱۲ و ۱۳] و بار دیگر از مقادیر بهینه شده‌ی آنها که موجب کمینه شدن انرژی می‌شوند استفاده شده است.

۳- بحث و نتایج

چگالی حالت‌های کلی جهت توصیف برخی خواص اپتیکی لازم اند که در شکل‌های ۱ و ۲ برای دو ساختار BNT و BNZ در گستره‌ی انرژی ۲۰ eV- تا ۱۴ eV نشان داده شده است. انرژی صفر نشان دهنده‌ی مکان تراز فرمی است. از آرایش اتمی پیداست که اوربیتال‌های O-2p عمدتاً زیر تراز فرمی قرار دارند اما به علت همپوشانی با اوربیتال‌های Bi و Na و Zr و تشکیل اوربیتال‌های هیبرید می‌توان الکترون‌های اوربیتال O-2p را بالای تراز فرمی نیز مشاهده کرد و بالعکس؛ یعنی اوربیتال‌های Na-3s و Zr-4d و Bi-6p که در بالای سطح فرمی بعد از انرژی گاف تشکیل می‌شوند زیر تراز فرمی هم درست در جایی که O-2p حضور دارد وجود دارند و این به طور قوی بیان می‌کند که اوربیتال‌های هیبرید جدیدی تشکیل شده است. اوربیتال‌های مغزه اتم‌های O و Bi و Na در فاصله‌ی دوری از تراز فرمی به طور جایگزیده تشکیل شده‌اند.

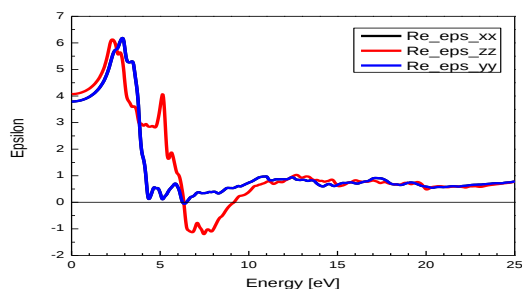


شکل ۱: چگالی حالت‌های کل ترکیب BNT

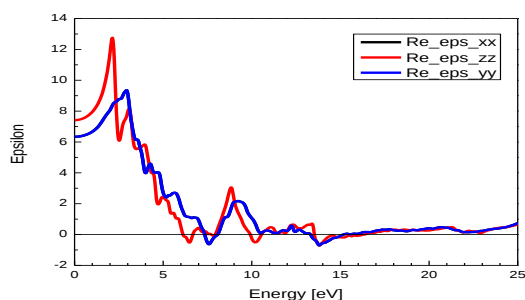


شکل ۲: چگالی حالت‌های کل ترکیب BNZ

ساختار نوارهای انرژی برای ترکیب‌های BNT و BNZ در فاز تتراگونال در نقاط و امتدادهایی با تقارن بالا در اولین منطقه‌ی بریلوئن در تقارن P4bm در محدوده‌ی انرژی ۱۴ eV- تا ۸ eV در شکل‌های ۳ و ۴ مشاهده می‌شود. گاف الکترونیکی محاسبه شده برای BNT، همان‌طور که در شکل مشخص شده است ۱/۹ eV می‌باشد و برای BNZ، ۱/۴۵ eV بدست آمده است که این مقادیر می‌توانند از داده‌های تجربی کمتر باشند. همان‌طور که مشاهده می‌شود با جایگزین شدن Zr به جای Ti گاف



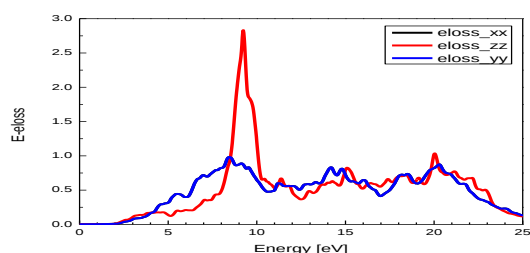
شکل ۵: قسمت حقیقی تابع دی الکتریک برای ترکیب BNT



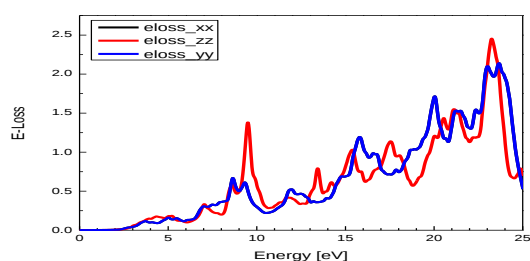
شکل ۶: قسمت حقیقی تابع دی الکتریک برای ترکیب BNZ

مشاهده می شود که نوسانات پلاسمونی در BNZ بیشتر از BNT است.

شکل های ۷ و ۸ تابع اتلاف انرژی را برای دو ترکیب نشان می دهند. با توجه به این شکل ها می توان دریافت که قله ی پلاسمونی در راستای z برای ترکیب BNT در انرژی ۹/۲۴ eV و در ترکیب BNZ در انرژی ۲۲/۹ eV، همچنین در راستای x و y برای ترکیب BNT در انرژی ۸/۵۰ eV و در ترکیب BNZ در انرژی ۳۲/۵۳ eV رخ داده است، که بیان کننده وجود یکی از فرکانس های تحریک پلاسمونی در این انرژی است.

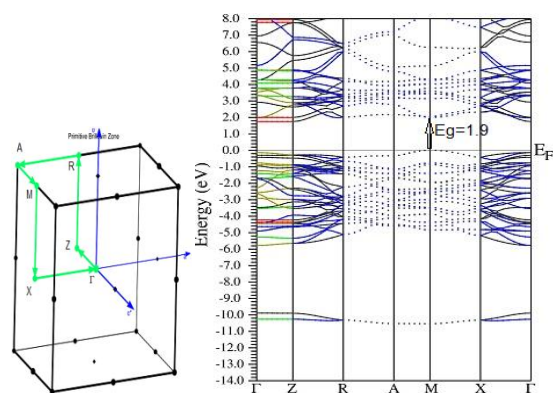


شکل ۷: تابع اتلاف انرژی برای BNT

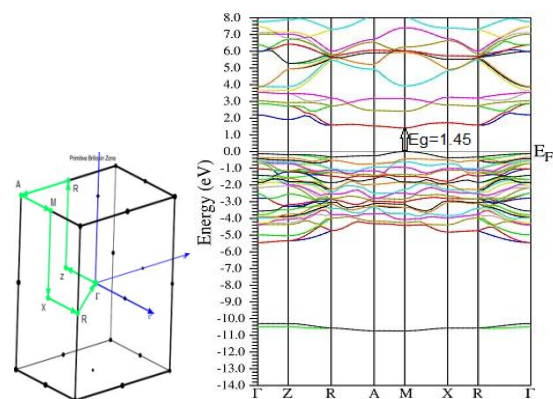


شکل ۸: تابع اتلاف انرژی برای BNZ

انرژی کاهش می یابد که نشان دهنده ی این است که سهم الکترون های Zr-4d در کاهش گاف بیشتر است و این با بزرگ بودن شعاع یونی Zr در توافق است.



شکل ۳: ساختار نوارهای انرژی ترکیب BNT در راستاها و مسیرهای مختلف در اولین منطقه ی بریلوئن و تعیین نقاط با تقارن بالا



شکل ۴: ساختار نوارهای انرژی ترکیب BNZ در راستاها و مسیرهای مختلف در اولین منطقه ی بریلوئن و تعیین نقاط با تقارن بالا

شکل های ۵ و ۶ قسمت حقیقی تابع دی الکتریک را برای دو ترکیب نشان می دهند. صفرهای این تابع، انرژی فرکانس مربوط به پلاسمون ها را مشخص می کند. همانطور که از نمودارها مشاهده می شود دو راستای X و Y کاملاً همسانگرد هستند یعنی نمودارهای هر دو راستا دقیقاً روی هم افتاده است. تعداد ریشه ها برای ترکیب BNT، ۶ تا هستند که در هر دو راستای X و Y در انرژی های ۶/۲۷ eV و ۶/۴۸ eV و در راستای Z در انرژی های ۶/۳۲ eV و ۹/۱۵ eV می باشد و برای ترکیب BNZ، ۱۷ ریشه داریم که در هر دو راستای X و Y در انرژی های ۷/۳۳ eV و ۷/۸۵ eV و ۱۳/۳۷ eV و ۱۴/۸۷ eV و در راستای Z در انرژی های ۶/۱۹ eV و ۱۴/۲۷ eV و ۹/۸۳ eV و ۱۰/۳۵ eV و ۱۳/۵۳ eV و ۱۴/۲۷ eV و ۱۴/۷۸ eV و ۱۵/۴۴ eV و ۱۵/۶۶ eV قرار دارند.

می‌دهد که این ترکیب برای انرژی‌های بالا آثار غیرهمسانگردی کمتری نسبت به انرژی‌های پایین دارد.

۴- نتیجه‌گیری

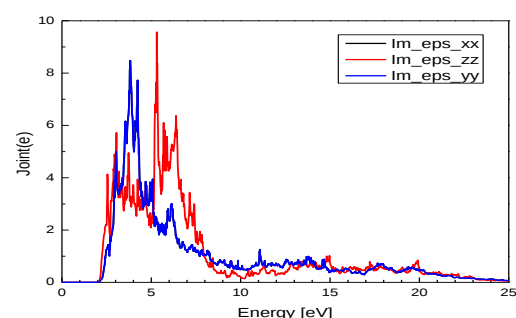
چگالی حالت‌های کل و توابع دی‌الکتریک، اتلاف انرژی و دیگر خواص الکتروپتیکی ترکیب‌های BNT و BNZ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. گاف بدست آمده در ترکیب BNT، $1/9\text{eV}$ است اما در ترکیب BNZ گاف به $1/45\text{eV}$ تقلیل می‌یابد که نشان می‌دهد سهم الکترون‌های Zr-4d در کاهش گاف بیشتر است و این از طرفی با بزرگ بودن شعاع یونی Zr در توافقی است. همچنین مشاهده شد که گاف اپتیکی در ترکیبات BNT و BNZ به ترتیب برابر با $2/2\text{eV}$ و $1/8\text{eV}$ هستند که این مقادیر از گاف الکترونی آنها بیشتر است.

مراجع

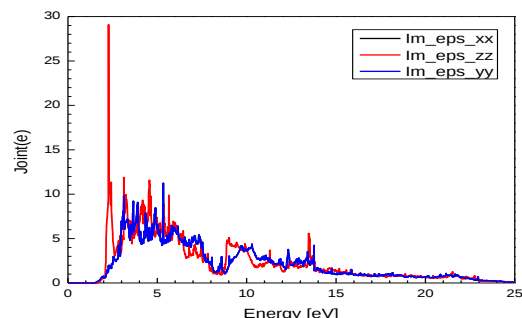
- [1] R del J., Klaus W.J., Seifert T.P., Anton E.M. and Granzow T., Perspective On the Development of Lead Free.Piezoceramics, *J. Am. Ceram. Soc.*, 2009;92(6): 1153-1177.
- [2] Smolensky G. A., Isupov V. A., Agranovskaya A. I., and Krainik N. N., *Sov. Phys. Solid State* 2 (1961) 2651.
- [3] Vakhrushev S. B., Isupov V. A., Kvyatkovsky B. E., Okuneva N. M., Pronin I. P., Smolensky G. A., and Symnikov P. P., *Ferroelectrics* 63 (1985) 153.
- [4] Suchanicz J. and Kwapulin'ski J., *Ferroelectrics* 165 (1995) 249.
- [5] Park S. E., Chung S. J., and Kim I. T., *Ceram J. Am., Soc.* 79 (1996) 1290.
- [6] Hosono Y., Harada K., and Yamashita Y., *Jpn. J. Appl. Phys., Part 1* 40 (2001) 5722.
- [7] Xu G., Duan Z., Wang X., and Yang D., *Cryst J., Growth* 275 (2005) 113.
- [8] Ge W. *et al.*, *Alloys Compd J.*, 462 (2008) 256.
- [9] Yia X., Chen H., Cao W., Zhao M., Yang D., Ma G., Yang C., and Han J., *Cryst J., Growth* 281 (2005) 364.
- [10] Lily K., Prasad K., Yadav K. L., Dielectric and impedance study of lead-free ceramic: $(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{ZrO}_3$, *J. Mater. Sci* 42 (2007) 6252-9.
- [11] Prasad K., Lily K., Kumari K., Yadav K. L., Hoping type of conduction in $(\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5})\text{ZrO}_3$, *J. Phys. Chem. Solid* 68 (2007) 1508-14.
- [12] Jones G. O. and Thomas P. A., ISSN 0108 (2000) 7681.
- [13] P. Jaiban1, S. Jansirisomboon 1, 2, A. Watcharapasorn. *Journal of the Microscopy Society of Thailand* 5 (1-2), (2012) 42-45.

در شکل‌های ۹ و ۱۰ شدت انتقال بین نواری $J_{\text{ev}}(E)$ برای دو ترکیب نشان داده شده است. ماکزیمم شدت انتقال برای ترکیبات BNT و BNZ در راستای x و y برابرند و به ترتیب برابر با $3/82$ و $3/06$ هستند همچنین ماکزیمم شدت انتقال برای راستای z به ترتیب عبارت از $5/30$ و $2/19$ هستند. حدود انرژی 20 eV ، شدت انتقال برای هر دو ساختار کاهش می‌یابد و به صفر نزدیکتر می‌گردد.

مشاهده می‌شود که گاف اپتیکی در ترکیبات BNT و BNZ به ترتیب برابر با $2/2\text{eV}$ و $1/8\text{eV}$ هستند که از گاف الکترونی آنها که به ترتیب $1/9\text{eV}$ و $1/45\text{eV}$ بودند بزرگتر است.



شکل ۹: شدت انتقال بین نواری در BNT



شکل ۱۰: شدت انتقال بین نواری در BNZ

همچنین سهم برانگیختگی‌ها در انرژی‌های پایین بیشتر مربوط به راستای Z می‌باشد زیرا چیدمان اتم‌ها در راستای Z به گونه‌ای است که اکسیژن در راستای [001] کمی از سطح صفحه بالاتر قرار گرفته است و این منجر به این شده است که فاصله‌ی پیوند بین اکسیژن و تیتانیوم کمتر شود. بنابراین الکترون‌ها آزادی بیشتری برای تحرک دارند که این موضوع باعث می‌شود که خواص اپتیکی این ترکیب بیشتر در راستای Z اهمیت پیدا کند. این موضوع برای انرژی‌های پایین صحیح به نظر می‌رسد اما همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود در انرژی‌های بالا اختلاف رفتار این دو جهت خیلی زیاد نیست. این موضوع نشان